# А.Н. Сердюков, Е.Б. Шершнев, Ю.В. Никитюк, В.Ф. Шолох, С.И. Соколов

УО «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины», Гомель, Беларусь

# КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ЛАЗЕРНОГО ТЕРМОРАСКАЛЫВАНИЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КВАРЦА

# Введение

В последнее время стали активно проводится исследования управляемого лазерного термораскалывания различных кристаллов [1–2]. Актуальность данного направления работ обусловлена рядом недостатков традиционных способов обработки, к которым в первую очередь относятся значительные потери обрабатываемого материала, загрязнение рабочих поверхностей и низкое качество реза.

Особо перспективным представляется применение управляемого лазерного термораскалывания для разделения кристаллического кварца, используемого при изготовлении кварцевых кристаллических

элементов.

Изучению особенностей управляемого лазерного термораскалывания кристаллического кварца посвящены работы [3-4], в которых верно указывается на необходимость учета кристаллографической ориентации обрабатываемого материала при выборе соответствующих параметров нужно отметить, обработки. Однако В данных что работах акцентируется внимание лишь на анизотропии теплового расширения игнорируется зависимость кристаллов кварца, при ЭТОМ OT кристаллографического направления теплопроводности И упругих свойств данных кристаллов.

## 1. Постановка задачи для численного решения

процесса Конечно-элементное моделирование лазерного термораскалывания кристаллического кварца было выполнено в два этапа: на первом этапе выполнялся расчёт полей температур, а на втором этапе решалась задача о нахождении термоупругих напряжений, формируемых в результате воздействия лазерного излучения И хладагента на обрабатываемый материал [5]. Такая последовательность получение результатов обеспечивает моделирования В рамках несвязанной задачи термоупругости в квазистатической постановке [6].

При определении направления развития лазерной трещины, был использован критерий максимальных растягивающих напряжений, в соответствии с которым трещина распространяется в направлении, перпендикулярном действию максимальных растягивающих напряжений [7]. При этом учитывалось, что трещина прекращает свой рост в зоне напряжений сжатия.

Для расчетов плотность и удельная теплоемкость кристаллического кварца полагались соответственно равными  $\rho = 2649 \text{ кг/м}^3$  и Дж/кг·К. При моделировании C = 732были учтены различия физических свойств кристаллического кварца В различных кристаллографических направлениях: коэффициент теплопроводности и коэффициент линейного термического расширения кристаллического кварца считались соответственно равными  $\lambda_{\parallel} = 12,3$  Вт/м ·K,  $\alpha_{\parallel} = 9.10^{-6}$ К<sup>-1</sup> вдоль оси симметрии третьего порядка Z и  $\lambda \perp$  = 6,8 Вт/м K, α⊥ = 14,8·10<sup>-6</sup> К<sup>-1</sup> в плоскости перпендикулярной оси Z. Для расчетов использовались следующие константы упругой жесткости: C<sub>11</sub> =  $C_{12} = 5,95 \cdot 10^9 \text{ MIIa}, C_{13} = 11,91 \cdot 10^9 \text{ MIIa}, C_{14}$  $C_{33} = 107,2 \cdot 10^9 \text{ MIIa}, C_{44} = 57,8 \cdot 10^9 \text{ MIIa}, C_{66}$ 86,75·10<sup>9</sup> МПа,  $= -17,8 \cdot 10^9 \text{ MHa},$  $=40,4\cdot10^9$  MIIa [8–10].

Расчеты проводились для квадратных пластин с геометрическими размерами  $20 \times 20 \times 1,5$  мм и  $20 \times 20 \times 0,75$  мм. Радиус пятна лазерного излучения R = 1,5 мм, мощность излучения P = 50 Вт. Скорость

перемещения пластины относительно лазерного пучка и хладагента выбиралась равной v = 5 мм/с.

Расчет термоупругих полей, формируемых в монокристаллической кварцевой пластине в результате последовательного лазерного нагрева и воздействия хладагента, осуществлялся для пяти различных вариантов: I – трехмерный анализ среза zy, при перемещении лазерного пучка в направлении оси Х; II – трехмерный анализ среза ух, при перемещении. лазерного пучка в направлении оси X; III – трехмерный анализ среза ух, при перемещении лазерного пучка в направлении оси Z; IV трехмерный анализ среза ху, при перемещении лазерного пучка в направлении оси Y; V – трехмерный анализ среза ху, при перемещении лазерного пучка в направлении оси Z. В соответствии с [10] для обозначения срезов использованы две буквы, обозначающие кристаллографические оси, вдоль которых расположен кристаллический элемент, при этом первая буква определяет, какая из осей направлена вдоль толщины образца.

### 2. Результаты конечно-элементного анализа

Результаты расчетов приведены в таблицах 1 и 2. Из анализа данных приведенных в таблице 1 следует, что максимальные значения температуры для всех расчетных режимов не превышают температуру плавления кристаллического кварца, что является необходимым условием для реализации хрупкого разрушения пластины под действием термоупругих напряжений.

В таблице 2 приведены расчетные значения максимальных по величине напряжений растяжения и сжатия, формируемые в зоне обработки при управляемом лазерном термораскалывании кристаллического кварца.

Таблица 1 – Расчетные значения максимальных температур в обрабатываемой пластине

2	S.	Максимальная температура в обрабатываемой пластине Т, К		
	Вариант	h = 0,75 мм	h = 1,5 мм	
	Ι	1546	1116	
	Ι	1468	1163	
	III	1523	1202	
	IV	1523	1202	
	V	1468	1163	

Сравнительный анализ данных приведенных в таблице 2 с результатами работ [3-4] позволяет сделать вывод о том, что при

выборе режимов лазерного термораскалывания кристаллов кварца необходимо учитывать не только анизотропию теплового расширения данного материала, но также необходимо учитывать зависимость от кристаллографического направления теплопроводности И упругих свойств кристаллов. При ЭТОМ существенное данных отличие вышеуказанных параметров от ориентации кристалла обуславливает необходимость осуществления дифференцированного нагрева при резке в различных кристаллографических направлениях.

Таблица	2 –	Расчетные	значения	максимальных	по величине
напряжений	$\sim$				

Вариант	Максимальные напряжения в зоне обработки σ <sub>y</sub> , МПа	h = 0,75 мм h = 1,5 мм	
I	растяжения	83,8	42,9
1	сжатия	641,9	414,2
п	растяжения	63,5	33,2
11	сжатия	512,7	355,9
ш	растяжения	85,1	56,2
111	сжатия	607,3	459,1
ТV	растяжения	93,1	73,0
1 V	сжатия	628,5	480,8
V	растяжения	65,7	34,3
v	сжатия	520,9	356,0

### Заключение

В данной работе выполнено конечно-элементное моделирование процесса управляемого лазерного термораскалывания кристаллического кварца. На основании выполненных расчетов показана необходимость учета анизотропии свойств данного материала при выборе параметров обработки.

## Литература

1. Наумов, А.С. Разработка технологии разделения приборных пластин на кристаллы: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.11.14 / А.С. Наумов; МГУПИ. – М., 2007. – 20 с.

2. Сердюков, А.Н. Особенности управляемого лазерного термораскалывания кристаллического кремния / А.Н. Сердюков, С.В. Шалупаев, Ю.В. Никитюк // Кристаллография. – 2010. – Т. 55. – № 6. – С. 1180–1184.

3. Способ резки хрупких неметаллических материалов: пат. 2224648 РФ, МКИ 7 В28D5/00, С03В33/00/ В.С. Кондратенко, П.Д. Гиндин;

заявитель В.С. Кондратенко, П.Д. Гиндин. – №2002123517/03; заявл. 03.09.02; опубл. 27.02.04

4. Гиндин, П.Д. Разработка новых технологий и оборудования на основе метода лазерного управляемого термораскалывания для обработки деталей приборостроения, микро- и оптоэлектроники: автореф. дис. ... докт. техн. наук: 05.11.14 / П.Д. Гиндин; МГУПИ. – М., 2009. – 44 с.

5. Коваленко, Л.Д. Основы термоупругости / Л.Д. Коваленко. – Киев: Наукова думка, 1970. – 307 с.

6. Шабров, Н.Н. Метод конечных элементов в расчетах деталей тепловых двигателей / Н.Н. Шабров. – Л.: Машиностроение, 1983. – 212 с.

7. Карзов, Г.П. Физико-механическое моделирование процессов разрушения / Г.П. Карзов, Б.З. Марголин, В.А. Шевцова. – СПб.: Политехника, 1993. – 391 с.

8. Корицкий, Ю.В. Справочник по электротехническим материалам / Ю.В. Корицкий, В.В. Пасынков, Б.М. Тареева. – Л.: Энергоатомиздат, 1988. – 728 с.

9. Смагин, А.Г. Пьезоэлектричество кварца и кварцевые резонаторы / А.Г. Смагин, М.И. Ярославский. – М.: Энергия, 1970. – 488 с.

10. Глюкман, Л.И. Пьезоэлектрические кварцевые резонаторы / Л.И. Глюкман. – М.: Радио и связь, 1981. – 232 с.

R